2Т664А9, 2Т664Б9

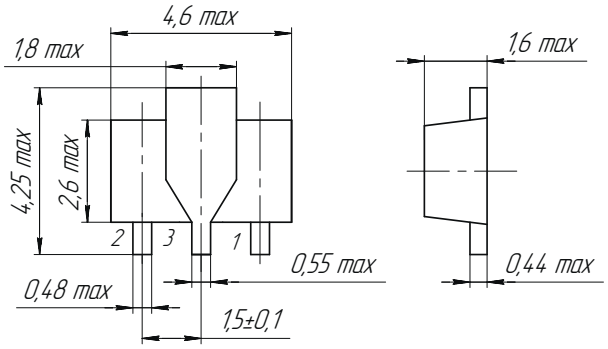
аА0.339.559 ТУ

аналоги BCX53
BCX52

Эпитаксиально-планарные транзисторы

Гибридные микросхемы, ключевые схемы, импульсные модуляторы, преобразователи, линейные стабилизаторы напряжения, узлы и блоки аппаратуры специального назначения.

$T_{экспл}$: - 60°C ...+125°C



1 — база
2 — эмиттер
3 — коллектор

Металлопластмассовый корпус КТ - 47(SOT - 89)

№ п/п	Наименование параметра, единица измерения (режим измерения при $T_{окр. ср.}$= +25°C)	Условное обозначение	Значение параметров			
			2Т664А9		2Т664Б9	
			не менее	не более	не менее	не более
1.	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБ\ max}$	120	-	100	-
2.	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор – эмиттер, В ($R_{БЭ}$ ≤ 1 кОм)	$U_{КЭ\ max}$	100	-	80	-
3.	Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер – база, В	$U_{ЭБ\ max}$	5	-	5	-
4.	Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{K\ max}$	-	1	-	1
5.	Статический коэффициент передачи тока, ($U_{КБ}$ = 2 В, $I_Э$ = 0,15 А)	$h_{21Э}$	40	250	40	250
6.	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_К$= 0,15 А, $I_Б$= 0,015 А)	$U_{КЭ\ нас}$	-	0,3	-	0,3
7.	Граничная частота коэффициента передачи тока, МГц	$f_{гр}$	50	200	50	200
8.	Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_К$ = +25°C, Вт	$P_{K\ max}$	-	1	-	1

Возможна поставка в бескорпусном исполнении разделенными или не разделенными на кристаллы

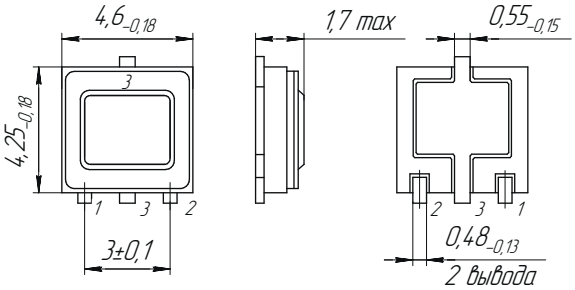
ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ

2Т664А91, 2Т664Б91

АЕЯР. 432140.561 ТУ

Мощные высокочастотные транзисторы

Усилительные и ключевые схемы
специальной техники.
$T_{экспл}$: - 60°С ...+125°С



1 — база
2 — эмиттер
3 — коллектор

Металлокерамический корпус 4601.3-1 для поверхностного монтажа

№ п/п	Наименование параметра, единица измерения (режим измерения при $T_{окр. ср.}$= +25°С)	Условное обозначение	Значение параметров			
			2Т664А91		2Т664Б91	
			не менее	не более	не менее	не более
1.	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБ\ max}$	120	-	100	-
2.	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор – эмиттер, В	$U_{КЭ\ max}$	100	-	80	-
3.	Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер – база, В	$U_{ЭБ\ max}$	5	-	5	-
4.	Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{К\ max}$	-	1	-	1
5.	Статический коэффициент передачи тока, ($U_{КБ}$ = 2 В, $I_Э$ = 0,15 А)	$h_{21Э}$	80	250	80	250
6.	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_К$= 0,15 А, $I_Б$= 0,015 А)	$U_{КЭ\ нас}$	-	0,3	-	0,3
7.	Граничная частота коэффициента передачи тока, МГц ($U_{КЭ}$= 5 В, $I_Э$= 50 мА, $f_{изм}$ = 1 МГц)	$f_{гр}$	50	200	50	200
8.	Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_К$ = +25°С, Вт	$P_{К\ max}$	-	3,6	-	3,6

Возможна поставка в бескорпусном исполнении разделенными или не разделенными на кристаллы